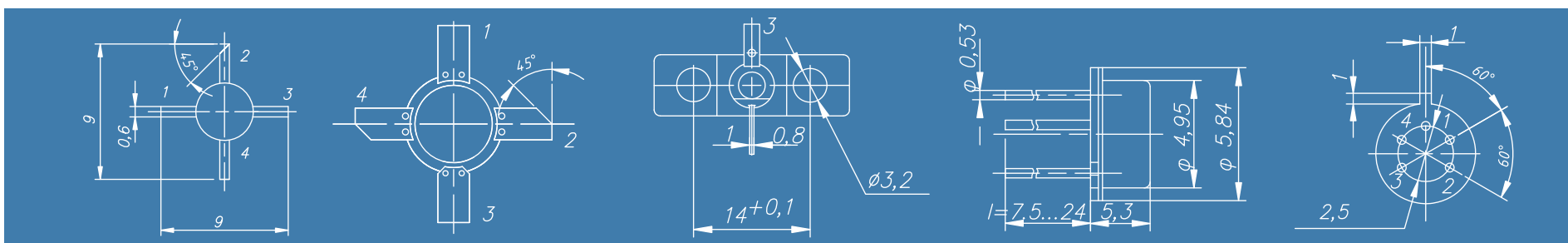
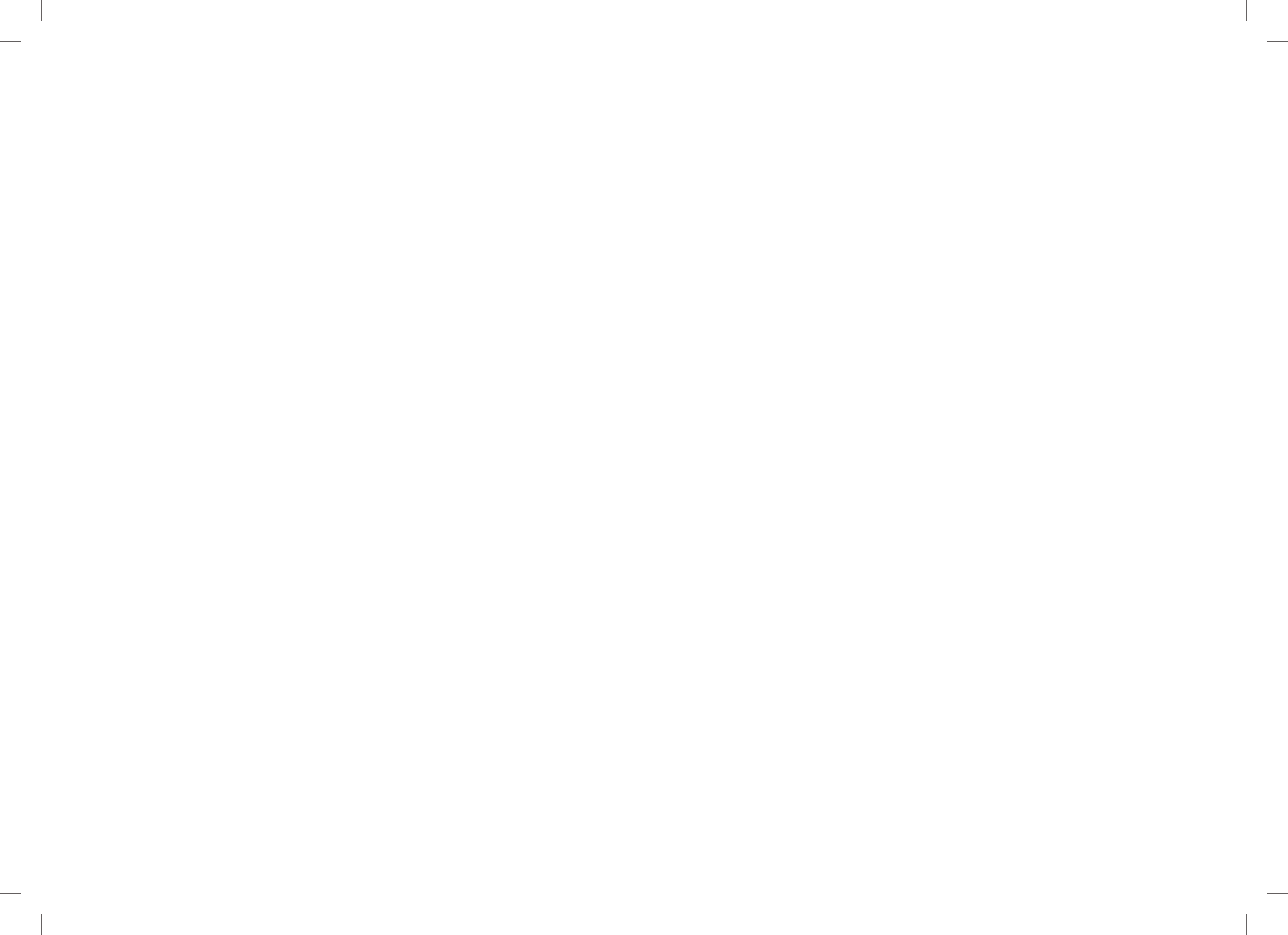




КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ





Оглавление Table of Contents

«Государственный завод «Пульсар».....3
“State plant “PULSAR”

ТРАНЗИСТОРЫ TRANSISTORS

Кремниевые p-n-p биполярные двухэмиттерные транзисторы.....4
Si p-n-p bipolar low power LF Two-Emitter transistors
2Т(КТ)118 А
2Т(КТ)118 Б
2Т(КТ)118 В

Кремниевые биполярные n-p-n малой
и средней мощности СВЧ малошумящие.....5
Silicon n-p-n bipolar low and medium power
microwave low noise transistors

2Т(КТ)372А, Б, В
КТ391В-2
2Т682А-2, Б-2
2Т(КТ)391А-2, Б-2
2Т(КТ)3132Б-2, В-2, Г-2
КТ3132Д-2, Е-2
2Т(КТ)3115А-2
2Т3115Б-2
КТ3115В-2, Г-2, Д-2

Кремниевые n-p-n биполярные
средней мощности СВЧ транзисторы.....6

Silicon n-p-n bipolar medium power microwave transistors
2Т(КТ)657А-2, Б-2, В-2
2Т(КТ)640А-2
2Т(КТ)643А-2
2Т(КТ)642А-2
2Т642Б-2
2Т(КТ)647А-2
2Т647-Б2
2Т671-А2
2Т(КТ)648А-2
2Т687АС-2
2Т687БС-2

Кремниевые n-p-n биполярные
мощные переключаемые транзисторы.....7
Silicon n-p-n bipolar high power switching transistors

2Т9113А1/ПМ
2Т(КТ)866А
2Т874А, Б
КТ874А, Б
2Т(КТ)862Б, В, Г

Кремниевые n-p-n биполярные мощные ВЧ транзисторы.....8
Silicon n-p-n bipolar high power RF transistors

2Т951Б
2Т950Б
2Т9111А, Б
2Т980А
2Т(КТ)921А
КТ921Б
2Т950А
2Т951А, В
2Т964А
2Т(КТ)980Б

Кремниевые n-p-n биполярные мощные СВЧ транзисторы.....9
Silicon n-p-n bipolar high power microwave transistors

2Т996А-2, Б-2, В-2, Г-2
2Т988А, Б
2Т9118Б
2Т946А
2Т(КТ)979А
2Т9118А
2Т(КТ)919А, Б, В
2Т942А, Б
2Т(КТ)948А
2Т(КТ)937А-2, Б-2
2Т982А-2
2Т9119А-2
2Т9205А-2, Б-2, В-2, Г-2, Д-2, Е-2
2Т963А-2, Б-2

Кремниевые p-n-p биполярные мощные ВЧ транзисторы.....11 Silicon p-n-p bipolar high power microwave transistors 2Т974 А, Б, В, Г	11
Кремниевые n-p-n биполярные мощные СВЧ импульсные транзисторы.....12 Silicon n-p-n bipolar high power microwave pulse transistors 2Т977А 2Т975А, Б 2Т986А, Б, В, Г 2Т994А, Б, В 2Т9203А-2, Б-2, В-2, Г-2, Д-2, Е-2 2Т9118В 2Т9127А, Б, В, Г, Д, Ж, Е, И, К 2Т9196 А-2, Б-2	12
Кремниевые маломощные полевые транзисторы с p-n переходом.....14 Silicon low power low noise amplifying p-n field-effect transistors 2П(КП)312А, Б КП341А, Б 2П341А, Б	14
Кремниевые маломощные полевые транзисторы с p-n переходом.....15 Silicon low power low noise amplifying p-n field-effect transistors 2П322А/ПМ 2П334А1/ПМ 2П334Б1/ПМ	15
Кремниевые мощные переключательные МДП транзисторы.....16 Silicon high power RF switching Field Effect Transistors 2П762А, Д, Н 2П712Г, Д 2П712Г1, Д1 2П762Ж, М 2П816А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Е1, Л1, М1	16
Сборки транзисторные и модули кремниевых эпитаксиально-планарных полевых с изолированным затвором переключательных транзисторов.....17 Transistor assemblies and modules of silicon epitaxial-planar field with isolated lock switching transistors	17

Сборки транзисторные Transistor assemblies 2П7120 АС, ВС, ВС, ГС, ДС, ЕС 2П7190 АР1, БР1, ВР1, ГР1, ЖР1, ЛР1, МР1, НР1, ПР1 2П7190 ДР, ЕР, ИР, КР, СР, ТР Модули Modules 2М215А, Б, В, Г	
Кремниевые полевые мощные ВЧ МДП транзисторы.....19 Silicon high power RF and microwave Field Effect Transistor 2П(КП)901А, Б 2П902А, Б КП902А, Б, В 2П(КП)903А, Б, В	19
Выпрямительные быстродействующие диоды.....20 HIGH-SPEED DIODES 2Д2931А, Б, В	20
Выпрямительные быстродействующие диоды.....21 HIGH-SPEED DIODES 2Д237А1/ПМ 2Д237Б1/ПМ 2Д237В1/ПМ 2Д237Г1/ПМ 2Д714АС1, 2	21
МИКРОСХЕМЫ MICROCIRCUITS	
Микросхемы мощные интегральные.....22 Power integrated circuits 286ЕП1АПМ 286ЕП2АПМ 286ЕП3АТПМ 286ЕП4АТПМ 286ЕП4АТПМ	22
Транзисторные усилители.....23 Transistors amplifiers М42114-5	23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВОД “ПУЛЬСАР” был основан в 1953 году как предприятие по разработке и производству полупроводниковых приборов, материалов и технологий.

АО “ГЗ “ПУЛЬСАР” – одно из первых отечественных предприятий в области полупроводниковой электроники, серийный изготовитель первых отечественных транзисторов.

АО “ГЗ “ПУЛЬСАР” один из крупнейших производителей ВЧ и СВЧ транзисторов, высокоточных быстро действующих диодов, мощных переключаемых транзисторов.

Основное применение выпускаемых изделий:

- Спутниковые, наземные, бортовые средства связи;
- Радиолокация;
- Навигация;
- Авиационное оборудование;
- Системы опознавания;
- Силовая электроника.

Изделия АО “ГЗ “ПУЛЬСАР” проходят жесткое тестирование и традиционно отличаются высокой степенью надежности.

АО “ГЗ “ПУЛЬСАР” располагает технологической базой, позволяющей разрабатывать и изготавливать полупроводниковые приборы на основе кремния и многокомпонентных полупроводников, проводить сложнейшие технологические процессы формирования эпитаксиальных структур и изготовление приборов.

Вся выпускаемая АО “ГЗ “ПУЛЬСАР” продукция снабжена техническими условиями в соответствии с действующими в отрасли требованиями и нормативами.

Выпускаемая нами продукция сертифицирована и отвечает современным требованиям к уровню качества!

Разработанные и выпускаемые нами изделия по своим техническим характеристикам не уступают аналогичным изделиям всемирно известных фирм и производятся с учетом новейших достижений в области технологии и конструирования.

Наша продукция широко известна и пользуется повышенным спросом в России и за рубежом!

АО “ГЗ “ПУЛЬСАР” выполняет как серийные, так и индивидуальные заказы потребителей, рассматривает предложения по совместной деятельности и организации совместного производства на базе высоких технологий.

State plant “PULSAR” was founded in 1953 as an enterprise for developing and manufacturing semiconductor devices, materials and technologies.

Joint stock company “State plant "PULSAR" is one of the first national enterprises in the area of semiconductor electronics, the first series manufacturer of transistors nationwide.

State plant "PULSAR" is one of the biggest manufacturers and suppliers of high-frequency and microwave transistors, fast high-current diodes, power switching transistors in Russia.

The main applications of devices in production:

- Communication units for satellites, ground-based stations and avionics;
- Radiolocation;
- Navigation;
- Avionic equipment;
- Recognition system;
- Power electronics.

Production of State plant "PULSAR" pass the rigid tests and are traditionally notable for their high reliability.

“State Plant “Pulsar” houses basic facilities for epitaxial growth, development and processing of semiconductor devices based on silicon and compound semiconductors.

All the products in the portfolio of State plant "PULSAR" is provided with specifications according to the state-of-art requirements and standards of the industry.

Our production is certificated and meets the modern quality requirements!

Performance of our products is comparable to the counterparts fabricated by the world-known companies. All the fabricated devices are designed and produced with regard to state-of-art achievements in semiconductor technology.

Our production is well known and favored both in Russia and abroad. State plant "PULSAR" takes both serial and individual customer orders.

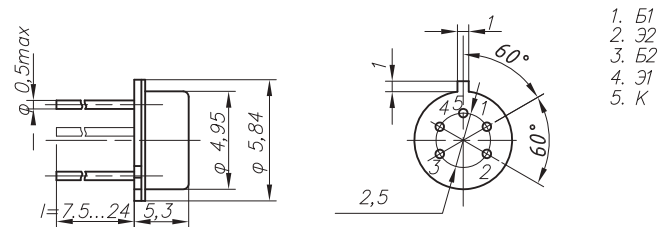
Proposals of cooperation and joint production on the advanced technology basis will be considered.

ТРАНЗИСТОРЫ TRANSISTORS

Кремниевые p-n-p биполярные двухэмиттерные транзисторы Si p-n-p bipolar low power LF Two-Emitter transistors

Тип изделия	P _{max} mW	U _o mV	R _t mW/ °C	Case Корпус	
				r _o Ohm	
2Т(КТ)118 А	100	0,2	0,4	20 100	КТ-1
2Т(КТ)118 Б	100	0,2	0,4	20 100	КТ-1
2Т(КТ)118 В	100	0,15	0,4	40 120	КТ-1

КТ-1



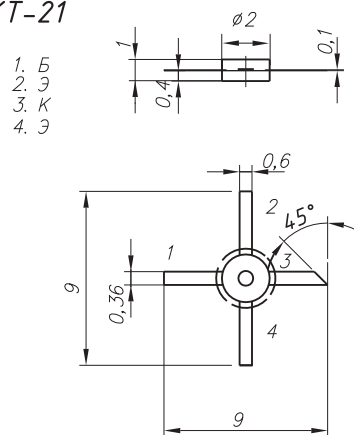
1. Б1
2. Б2
3. Б2
4. Б1
5. К

Кремниевые биполярные n-p-n малой и средней мощности СВЧ малошумящие
Silicon n-p-n bipolar low and medium power microwave low noise transistors

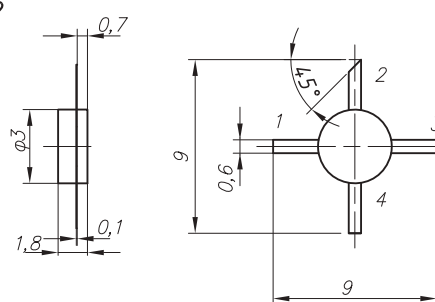
Type number Тип изделия	Frequency		F @ f		G _p @ f		Maximum Ratings			Case Корпус
	f _r , GHz	I _E , mA	dB, max	MHz	dB, min	MHz	U _{CEO} , V	I _C , mA	P, mW	
2Т(КТ)372А	3	5	3,5	1000	12	1000	15	10	50	КТ-23
2Т(КТ)372В	3	5	5,5	1000	12	1000	15	10	50	КТ-23
2Т(КТ)372Б	3	5	5,5	1000	12	1000	15	10	50	КТ-23
КТ391В-2	1	5	6	3600	4	3600	10		70	КТ-22
2Т682А-2*	4,7	20	4	3600	7	3600	10	50	350	КТ-22
2Т682Б-2**	4,7	20	4	3600	7	3600	10	50	350	КТ-22
2Т(КТ)391А-2	1	5	4,5	3600	6	3600	10	10	70	КТ-22
2Т(КТ)391Б-2	1	5	5,5	3600	6	3600	10	10	70	КТ-22
2Т(КТ)3132А-2	6,5	3	2	2250	8	2250	10	-	70	КТ-21
2Т(КТ)3132Б-2	6,5	3	2,5	3600	6	3600	10	-	70	КТ-21
2Т(КТ)3132В-2	6,5	3	5	6000	4	6000	10	-	70	КТ-21
2Т(КТ)3132В-2	6,5	3	5	5000	5	5000	10	-	70	КТ-21
2Т(КТ)3132Г-2	6,5	3	3,6	4000	6	4000	10	-	70	КТ-21
КТ3132Д-2	6,5	3	2	2250	8	2250	10	-	70	КТ-21
КТ3132Е-2	6,5	5	2,5	2250	8	2250	10	-	70	КТ-21
2Т(КТ)3115А-2	7	5	5	5000	5	5000	10	8,5	70	КТ-22
2Т3115Б-2	7	5	3,6	4000	6	4000	10	8,5	70	КТ-22
КТ3115В-2	7	5	4,6	5000	4	5000	7	8,5	50	КТ-22
КТ3115Г-2	7	5	6	5000	5	5000	10	8,5	70	КТ-22
КТ3115Д-2	7	5	2,5	2250	8	2250	10	8,5	70	КТ-22

*-h21>40, **-

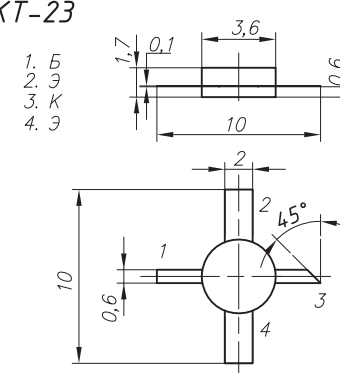
КТ-21



КТ-22



КТ-23



АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
г. Москва, Окружной пр., д.27
тел./факс: +7(499) 369 48 62;
+ 7 (495) 603 56 99
www.gz-pulsar.ru

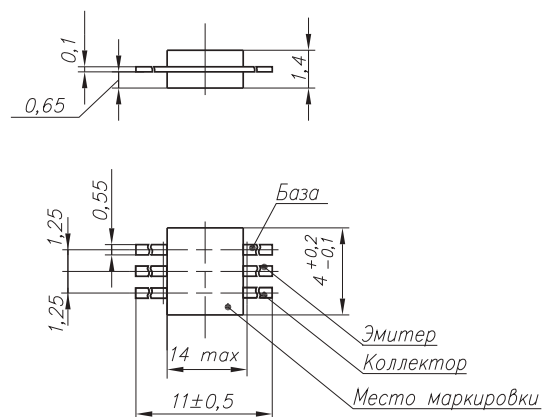
Кремниевые n-p-n биполярные средней мощности СВЧ транзисторы
Silicon n-p-n bipolar medium power microwave transistors

Тип изделия Type number	P_{out}	G_p	f_{max}	Frequency band	U_{CC}	R_t	Case Корпус
	mW	dB	GHz	GHz	V	C/W	
2Т(КТ)657А-2	50	8	2	< 2	7	200	КТ-22
2Т(КТ)657Б-2	50	8	2	< 2	7	200	КТ-22
2Т(КТ)657В-2 *	50	8	2	< 2	7	200	КТ-22
2Т(КТ)640А-2	100	6	7	1-7,2	15	150	КТ-22
2Т(КТ)643А-2	500	4	7	2-8,0	15	90	КТ-22
2Т(КТ)642А-2	100	4	8	1-8,15	12	150	КТ-22
2Т(КТ)647А-2	200	3	10	1-10,0	15	125	КТ-22
2Т647-Б2	180	2,5	10	-	15	125	КТ-22
2Т671-А2	350	5,1	8,5	2-8,5	12	130	КТ-22
2Т(КТ)648А-2	50	3	12	1-12,0	12	175	КТ-22
2Т687АС-2**	1,5W(P_{cmax} , pulse)	10(h _{21E})	-	-	-	67	нестанд.
2Т687БС-2**	1,5W(P_{cmax} , pulse)	10(h _{21E})	-	-	50	67	нестанд.

* h_{21E35-70}

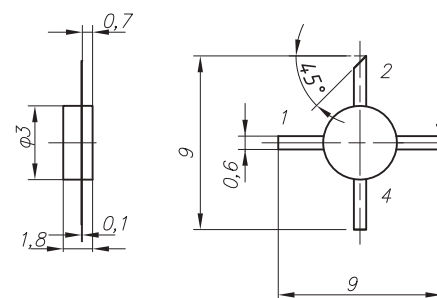
** p-n-p

2Т687-2



КТ-22

1. Б
2. К
3. Б
4. Э

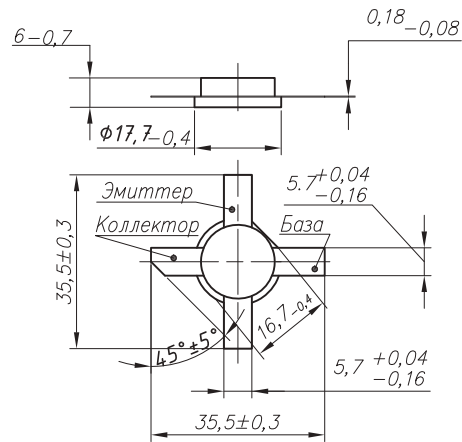


АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
г. Москва, Окружной пр., д.27
тел./факс: +7(499) 369 48 62;
+ 7 (495) 603 56 99
www.gz-pulsar.ru

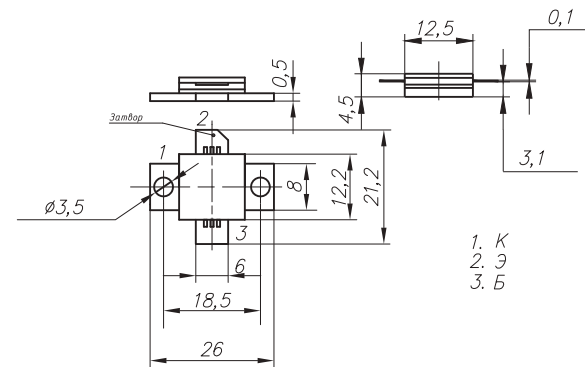
Кремниевые n-p-n биполярные мощные переключательные транзисторы
Silicon n-p-n bipolar high power switching transistors

Тип изделия Type number	U_{CE} V	I_C A	U_{CEsat} V	I_C A	I_B A	h_{21e}	U_{CE} V	I_C A	Max. Ratings		fr MHz	Case Корпус
									I_C A	Pmax. W		
2Т9113А1/ПМ	70	0,4	0,8	5	1,5	>25	5	5	5	50	30	КТ-19А-3
2Т(КТ)866А	100	0,2	1,5	10	1	>15	10	10	20	30	25	КТ-57
2Т874А	100	0,1	1	30	5	>15	5	30	30	75	20	КТ-57
КТ874А	100	0,1	1,2	30	5	>15	5	30	30	75	20	КТ-57
2Т874Б	120	0,1	1	30	5	>10	5	30	30	75	20	КТ-57
КТ874Б	120	0,1	1,2	30	5	>10	5	30	30	75	20	КТ-57
2Т(КТ)862Б	250	0,1	2	15	2	12...100	5	8	15	50	25	КТ-57
2Т(КТ)862В	350	0,1	1,5	8	2	12...50	5	5	10	50	25	КТ-57
2Т(КТ)862Г	400	0,1	1,5	8	2	12...50	5	5	10	50	25	КТ-57

КТ-19А-3

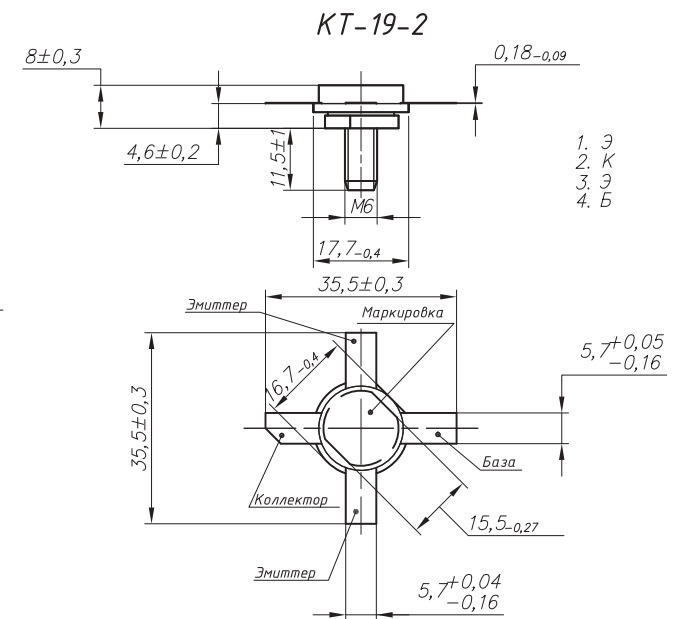
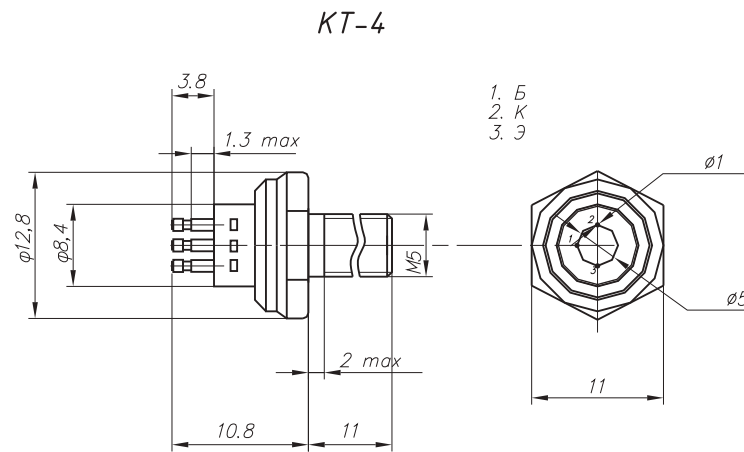
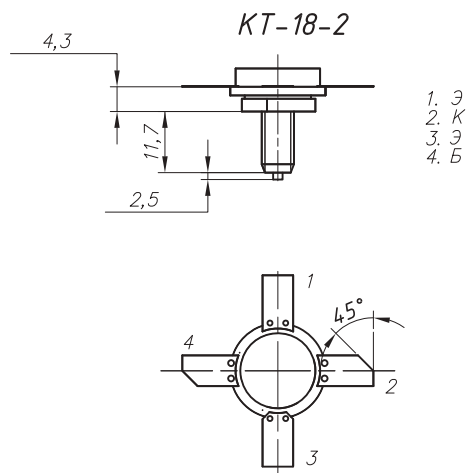
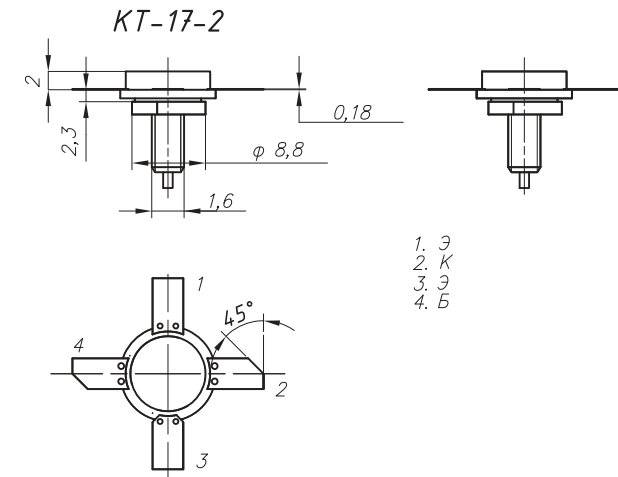


КТ-57



Кремниевые n-p-n биполярные мощные ВЧ транзисторы Silicon n-p-n bipolar high power RF transistors

Туренumber Тип изделия	Frequency	P _{out}	G _p	Efficiency	R _{фс}	U _{CC}	Case Корпус
	MHz	W	dB	%	C/W	V	
2T951Б	30	20	10	40	4,25	28	КТ-17
2T950Б	30	50	10	40	1,75	28	КТ-18
2T9111А	80	150	10	10	0,75	50	КТ-19-2
2T9111Б	100	150	10	10	1,0	50	КТ-19-2
2T980А	30	250	25	35	0,57	50	КТ-19
2Т(КТ)921А	60	12,5	8	50	6	27	КТ-4(ТО-60)
КТ921Б	60	12,5	5	40	6	27	КТ-4(ТО-60)
2T950А	80	70	7	65	1,25	28	КТ-18-2
2T951В	80	3	15	50	12,1	28	КТ-17-2
2T951А	80	25	8,3	60	2,83	28	КТ-17-2
2T964А	80	150	5	40	0,75	40	КТ-19-2
2Т(КТ)980Б	80	250	5	30	0,57	50	КТ-19-2



АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
г. Москва, Окружной пр., д.27
тел./факс: +7(499) 369 48 62;
+ 7 (495) 603 56 99
www.gz-pulsar.ru

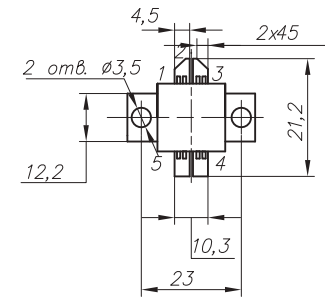
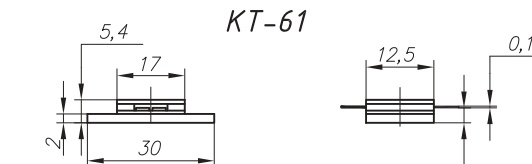
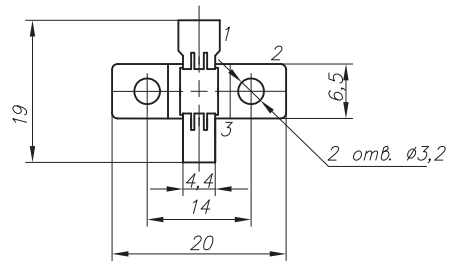
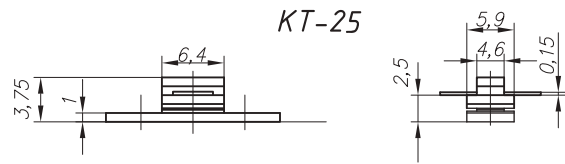
Кремниевые n-p-n биполярные мощные СВЧ транзисторы
Silicon n-p-n bipolar high power microwave transistors

Typenumber Тип изделия	Frequency band	P _{out}	G _p	Frequency	Efficiency	U _{CC}	R _{thJC}	Case Корпус
	GHz	W	dB	GHz	%	V	C/W	
2Т996А-2*	f _i =4	-	35	-	-	10	40	нестанд.
2Т996Б-2*	f _i =4	-	70	-	-	10	40	нестанд.
2Т996В-2*	0,65	0,115	35	0,65	-	10	40	нестанд.
2Т996Г-2	0,65	0,135	35	0,65	-	10	40	нестанд.
2Т988А	0,7-1,0	15	6	0,7-1,0	40	28	3,5	КТ-57
2Т988Б	0,9-1,4	18	7,8	0,9-1,4	50	28	4,5	КТ-57
2Т9118Б**	1,2-1,45	75	6	1,2-1,4	45	32	1,15	КТ-61
2Т946А	0,4-1,5	27	6,64		50	28	4	КТ-25
2Т979А	0,7-1,4	50	6	1,3	50	28	2	КТ-57
2Т9118А	0,9-1,45	75	6	1,3	40	28	1,15	КТ-61
2Т(КТ)919А	0,7-2,4	4,4	6,45	2	33	28	12	КТ-20
2Т(КТ)919Б	0,7-2,4	2	6	2	30	28	25	КТ-20
2Т(КТ)919В	0,7-2,4	1	7	2	25	28	40	КТ-20
2Т942Б	0,7-2,4	7	3,7	2	25	28	8	КТ-20
2Т942А	0,7-2,4	9	3,5	2	30	28	7	КТ-20
2Т(КТ)948А	0,7-2,3	15	4,8	2	35	28	4,5	КТ-54
2Т(КТ)937А-2	0,9-5	1,6	1,6	5	35	21	34,5	КТ-20
2Т(КТ)937Б-2	0,9-5	3,6	1,8	5	39	21	17	КТ-20
2Т982А-2	3-7,0	3,2	2,5	7	50	17	44	КТ-52
2Т9119А-2	7	4,5	3	7	37	15	15	КТ-52
2Т9205А-2*	0,43-0,44	65	9	0,43-0,44	65	25	1,4	нестанд.
2Т9205Б-2*	0,43-0,44	55	10	0,43-0,44	65	25	2,1	нестанд.
2Т9205В-2*	0,43-0,44	40	10	0,43-0,44	65	25	2,8	нестанд.
2Т9205Г-2*	0,43-0,44	20	10	0,43-0,44	65	25	5,6	нестанд.
2Т9205Д-2*	0,43-0,44	8	10	0,43-0,44	65	25	11,4	нестанд.
2Т9205Е-2*	0,43-0,44	90	9	0,43-0,44	65	25	1,2	нестанд.
2Т963А-2	2-10,0	0,8	3	10	27,8	15	74	КТ-52
2Т963Б-2	2-10,0	0,5	3	10	36	12	100	КТ-52

*h_{21E}=35-70

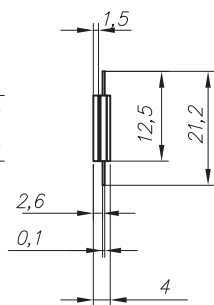
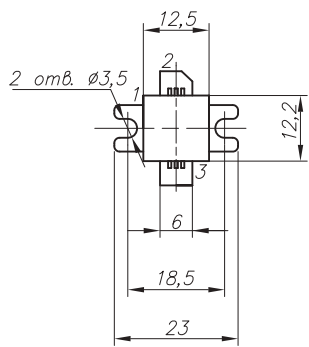
**τ_H=30 max, Q=5

АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
г. Москва, Окружной пр., д.27
тел./факс: +7(499) 369 48 62;
+ 7 (495) 603 56 99
www.gz-pulsar.ru

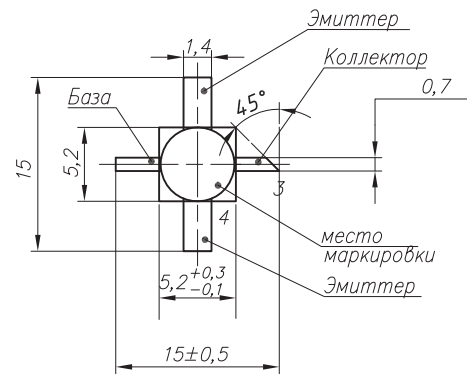
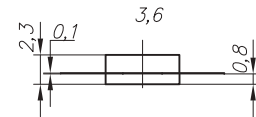


- 1. Б
- 2. К
- 3. К
- 4. Э
- 5. Э

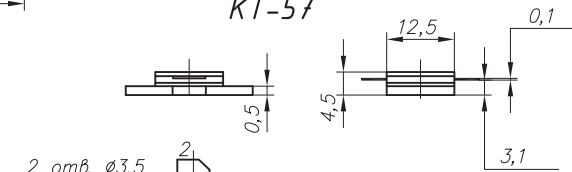
2T9205



2T996A-2 2T996Б-2

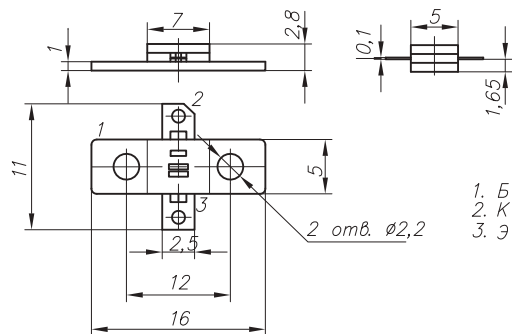


KT-57



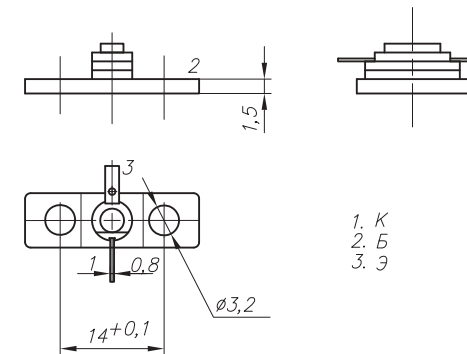
- 1. Б
- 2. К
- 3. Э

KT-52



- 1. Б
- 2. К
- 3. Э

KT-20



- 1. К
- 2. Б
- 3. Э

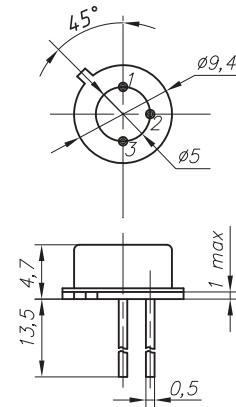
АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
г. Москва, Окружной пр., д.27
тел./факс: +7(499) 369 48 62;
+ 7 (495) 603 56 99
www.gz-pulsar.ru

Кремниевые p-n-p биполярные мощные ВЧ транзисторы
Silicon p-n-p bipolar high power RF transistors

Type number Тип изделия	P_{max}	U_{max}	f_t	$I_C max$	U_{BE}	$R_{\theta JC}$	Case Корпус
	W	V	MHz	A	V	C/W	
2Т974 А	5	80	300	2	0,9,,,1,5	20	КТ-3-7
2Т974 Б	5	60	300	2	0,9,,,1,2	20	КТ-3-7
2Т974 В	5	50	300	2	0,9,,,1,5	20	КТ-3-7
2Т974 Г	5	60	300	2	0,9,,,1,2	20	КТ-3-7

КТ-3-7

1. Э
2. Б
3. К



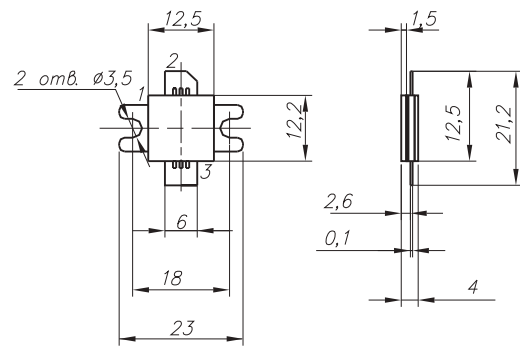
АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
г. Москва, Окружной пр., д.27
тел./факс: +7(499) 369 48 62;
+ 7 (495) 603 56 99
www.gz-pulsar.ru

Кремниевые n-p-n биполярные мощные СВЧ импульсные транзисторы
Silicon n-p-n bipolar high power microwave pulse transistors

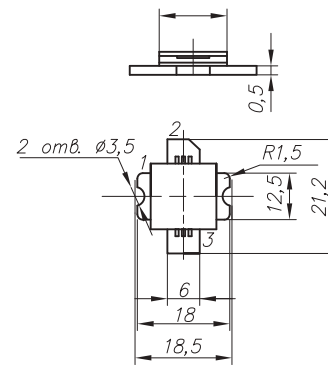
Typenumber Тип изделия	P _{out} W	G _p dB	Frequency GHz	Efficiency %	U _{CC} V	R _{qJC} C/W	τ mcS	Q	Case Корпус
2T977A	50	-	1,5	20	40	0,45	10	100	КТ-25
2T975A	200	6	1,5	30	45	0,19	10	100	КТ-59
2T975Б	100	6	1,5	35	45	0,38	10	100	КТ-59
2T986A	350	6	1,5	30	45	0,12	10	100	КТ-59
2T986Б	300	6	1,5	30	45	0,15	10	100	КТ-59
2T986В	350	7	1,5	35	45	0,12	10	100	КТ-59
2T986Г	350	6	0,8	35	45	0,12	10	100	КТ-59
2T994A	500	7	1,5	30	45	0,09	10	100	КТ-62
2T994Б	400	6	1,5	30	45	0,1	10	100	КТ-62
2T9 03A-2	100	7	1,21-1,44	45	35	0,7	500	5	нестанд.
2T9 03Б-2	50	7	1,21-1,44	45	35	1,4	500	5	нестанд.
2T9 03В-2	25	7	1,21-1,44	45	35	2,8	500	5	нестанд.
2T9203Г-2	150	6	1,5	40	35	0,36	50	10	нестанд.
2T9203Д-2	50	7	1,5	45	35	0,8	50	10	нестанд.
2T9203 Е-2	25	7	1,5	45	35	1,6	50	10	нестанд.
2T9118В*	75	6	0,96-1,22	45	28	1,15	----	5	КТ-61
2T9127A	500	6	1,025-1,150	35	45	0,1	10	100	КТ-55
2T9127Б	500	6	1,025-1,150	35	45	0,1	10	100	КТ-55
2T9127В	500	6	1,025-1,150	35	45	0,1	10	100	КТ-55
2T9127Г	250	6	1,025-1,150	35	45	0,2	10	100	КТ-55
2T9127Д	250	6	1,025-1,150	35	45	0,2	10	100	КТ-55
2T9127Ж	500	6	0,82-0,92	35	45	0,1	10	100	КТ-55
2T9127Е	125	6	1,025-1,150	35	45	0,4	10	100	КТ-55
2T9127И	250	6	0,82-0,92	35	45	0,2	10	100	КТ-55
2T9127К	125	6	0,82-0,92	35	45	0,4	10	100	КТ-55
2T9196 А-2	350	6	1,0;1,5	40	40	0,85	30	50	нестанд.
2T9196 Б-2	150	6	1,0;1,5	40	40	1,7	30	50	нестанд.

* в непрерывном режиме *with input inductance

2T9203

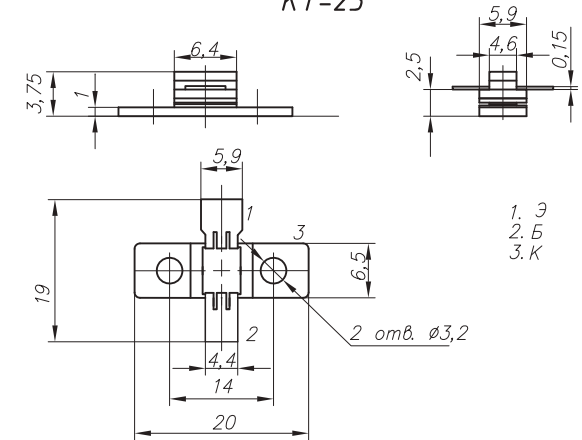


KT-59



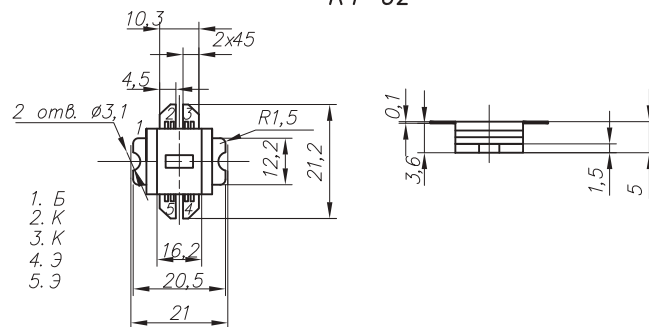
- 1. Б
- 2. К
- 3. З

KT-25



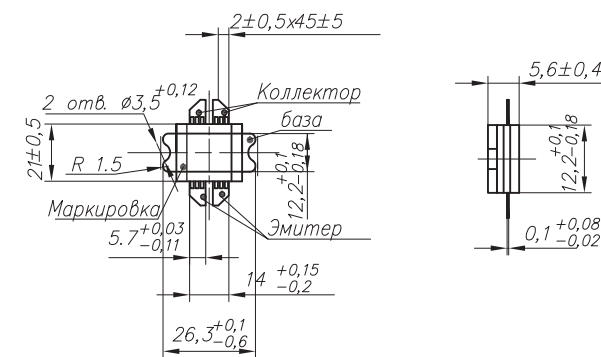
- 1. З
- 2. Б
- 3. К

KT-62



- 1. Б
- 2. К
- 3. К
- 4. З
- 5. З

2T9196A-2



Кремниевые маломощные полевые транзисторы с р-п переходом
Silicon low power low noise amplifying p-n field-effect transistors

Тип изделия Type number	F @ f		E _n @ f		G _p @ f		Maximum Ratings			Case Корпус
	dB, max	MHz	nV*sqrt(Hz)	KHz	dB min	MHz	U _{DS} , V	I _D , mA	P _{max} , mW	
2П(КП)312А	4	400	-	-	2	400	20	25	100	КТ-23
2П(КП)312Б	6	400	-	-	2	400	20	25	100	КТ-23
КП341А	-	-	1,2	100	-	-	15	30	200	КТ-23
КП341Б	-	-	1,8	100	-	-	15	30	200	КТ-23
2П341А*	-	-	1,2	100	-	-	15	5	150	КТ-23
2П341Б**	-	-	1,2	100	-	-	15	5	150	КТ-23

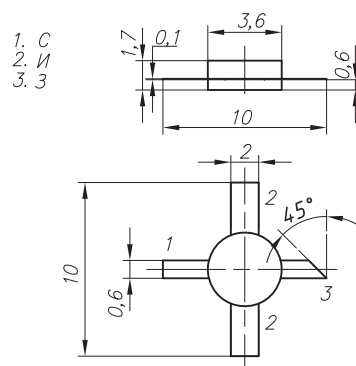
*-G_{ms}>15mA/V

**_

G_{ms}>18mA/V

E_n-noise force electrovelocity

КТ-23



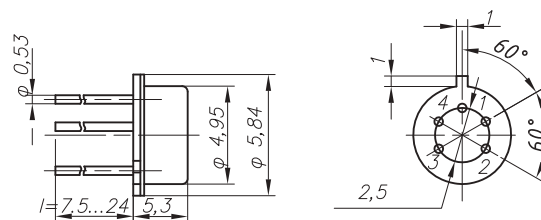
Кремниевые малошумящие полевые транзисторы с р-п переходом
Silicon low power low noise amplifying p-n field-effect transistors

Type number Тип изделия	I_{GSS}	S	I_{DSS}	$U_{GS(off)}$	E	F_{min}	$U_{GS\ max}$	$U_{DS\ max}$	$U_{GD\ max}$	$P_{\ max}$	Case Корпус
	A	ma/V	mA	V	nV/?Гц	dB	V	V	V	mW	
2П322А/ПМ	10^{-8}	4	40	-	-	6,0	-20	20	-25	200	301.6-1
2П334А1/ПМ*	$5 \cdot 10^{-10}$	5	2÷15	-0,3÷-2	15*	5,5**	30	25	30	200	КТ-1-15
2П334Б1/ПМ**	$5 \cdot 10^{-10}$	7	10÷35	-8	15*	5,5**	30	25	30	200	КТ-1-15

*f=1 кГц;
**f=2·10⁵ кГц

КТ-1-15

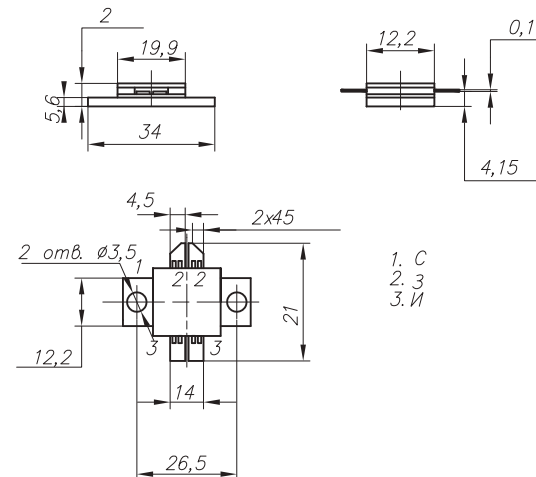
1. И
2. С
3. З
4. С



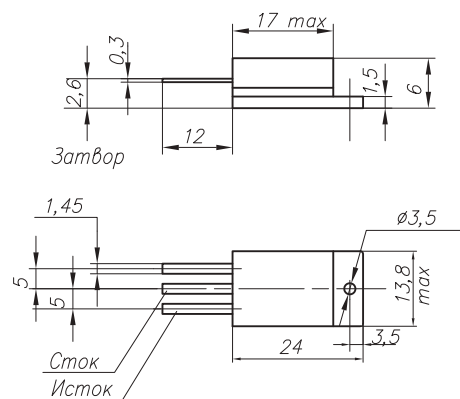
Кремниевые мощные переключаемые МДП транзисторы
Silicon high power RF switching Field Effect Transistors

Тип изделия	U_{DS} V	$I_{D\ max}$ A	$R_{DS\ (on)}$ Ohm	$P\ max$ W	Case Корпус
2П762А	100	30 (pulse)	0,085	80	КТ-57
2П762Д	150	30 (pulse)	0,1	80	КТ-57
2П762Н	200	80	0,2	80	КТ-57
2П712Г	-100	25	0,15	100	КТ-57
2П712Д	-200	15	0,3	100	КТ-57
2П712Г1	-100	40	0,1	230	нестанд.
2П712Д1	-200	30	0,2	230	нестанд.
2П762Ж	150	20	0,2	80	КТ-57
2П762М	60	30	0,05	80	КТ-57
2П816А	800	11	1	125	КТ-61А
2П816Б	1000	9	1	125	КТ-61А
2П816В	800	11	1,2	125	КТ-61А
2П816Г	1000	9	1,2	125	КТ-61А
2П816К	500	25	0,4	180	КТ-61
2П816Е1	500	16	0,8	125	нестанд.
2П816Л1	500	22	1,6	165	нестанд.
2П816М1	1000	14	1,4	165	нестанд.

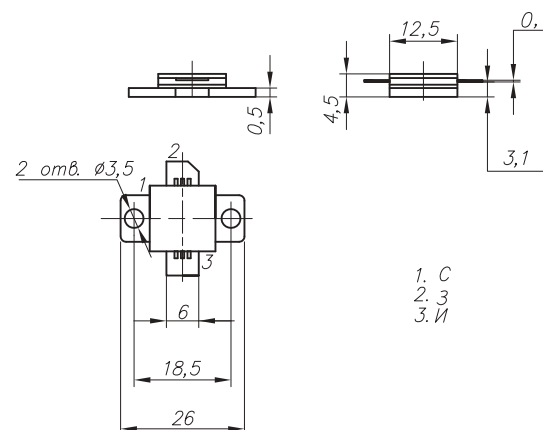
КТ-61 А



нестанд.



КТ-57



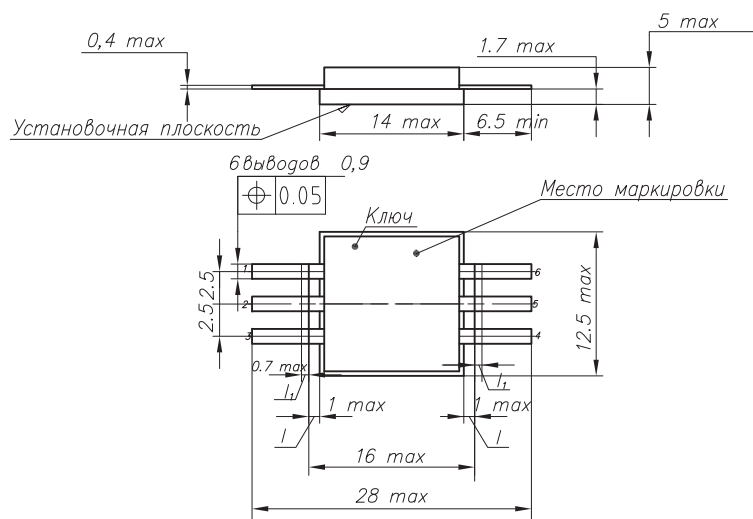
АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
г. Москва, Окружной пр., д.27
тел./факс: +7(499) 369 48 62;
+ 7 (495) 603 56 99
www.gz-pulsar.ru

Сборки транзисторные и модули кремниевых эпитаксиально-планарных полевых с изолированным затвором переключательных транзисторов
 Transistor assemblies and modules of silicon epitaxial-planar field with isolated lock switching transistors

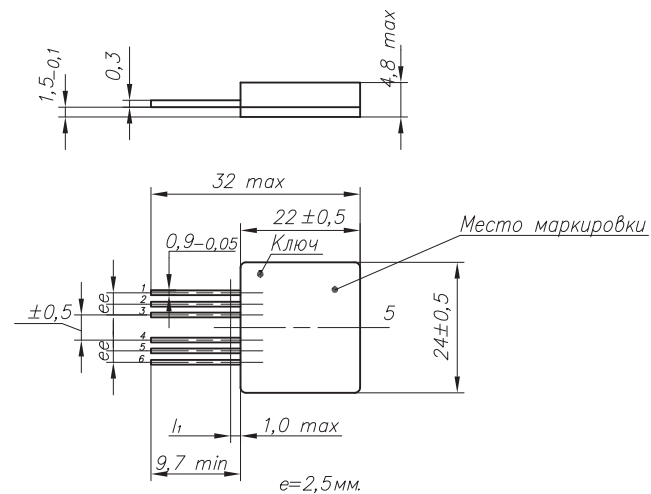
СБОРКИ

Typenumber Тип изделия	U _{DS max}	I _{GSS}	R _{DS (on)}	I _{DSS}	U _{GST}	I _{D max} /I _{D и max}	Case Корпус
	В	А	Ом	мА	В	А	
2П7120 АС	150	3·10 ⁻⁷	0,2	2	2-4	10/12	427.8-1
2П7120 БС	200	3·10 ⁻⁷	0,5	2	2-4	10/12	427.8-1
2П7120 ВС	150	3·10 ⁻⁷	0,2	2	2-4	10/12	нестанд.
2П7120 ГС	200	3·10 ⁻⁷	0,5	2	2-4	10/12	
2П7120 ДС	150	3·10 ⁻⁷	0,2	2	2-4	10/12	
2П7120 ЕС	200	3·10 ⁻⁷	0,5	2	2-4	10/12	
		nA					
2П7190 АР1	30	100	0,02	0,5	1,5-2,5	25/50	нестанд.
2П7190 БР1	100	100	0,1	0,5	1,5-2,5	12/24	
2П7190 ВР1	200	100	0,2	0,5	1,5-2,5	9/18	
2П7190 ГР1	-30	100	0,05	1	от -2,2 до -07	15/30	
2П7190 ДР	-100	100	0,1	1	от -2,2 до -07	17/34	нестанд.
2П7190 ЕР	-200	100	0,2	1	от -2,2 до -07	10/20	
2П7190ЖР1	30 (п- канал.) -30 (р-канал.)	100	0,05	0,5 1	от 1,5 до -2,5 от-2,2 до -0,7	25/50 (п - канал) 15/30 (р- канал)	
2П7190ИР	100(п- канал.) -100 (р-канал.)	100	0,1	0,5 1	от 1,5 до -2,5 от-2,2 до -0,7	12/34 (п - канал) 17/34 (р- канал)	
2П7190КР	200(п- канал.) -200(р-канал.)	100	0,2	0,5 1	от 1,5 до -2,5 от-2,2 до -0,7	9/18 (п - канал) 10/20 (р- канал)	нестанд.
2П7190ЛР1	30	100	0,02	0,5	от 2 до 4	25/50	
2П7190МР1	100	100	0,1	0,5	от 2 до 4	12/24	
2П7190НР1	200	100	0,2	0,5	от 2 до 4	9/18	
2П7190ПР1	-30	100	0,05	1	от -4 до -2	15/30	нестанд.
2П7190СР	-100	100	0,1	1	от -4 до -2	17/34	
2П7190ТР	-200	100	0,2	1	от -4 до -2	10/20	

2П7120; 2П7190; АР1-ГР1, ЖР1, ЛР1, МР1, НР1



2П7190 ДР,ЕР,ИР,КР,СР,ТР



Кремниевые полевые мощные ВЧ МДП транзисторы
Silicon high power RF and microwave Field Effect Transistor

Туренumber Тип изделия	P_{out}	G_p	Frequency	Efficiency	U_{DS}	P_{max}	Case Корпус
	mW	dB	MHz	%	V	W	
2П(КП)901А	10	10	100	40	50	20	КТ-4
2П(КП)901Б	6,7	-	100	-	50	20	КТ-4
2П902А*	1,2	2,9	400	-	50	3,5	КТ-4
2П902Б	1,2	2,9	400	-	50	3,5	КТ-4
КП902А*	1,2	12	500	-	50	3,5	КТ-4
КП902Б*	1,2	12	500	-	50	3,5	КТ-4
КП902В**	1,2	12	500	-	50	3,5	КТ-4
2П(КП)903А'	450	11	30	-	10	6	КТ-4
2П(КП)903Б''	450	11	30	-	10	6	КТ-4
2П(КП)903В'''	450	11	30	-	10	6	КТ-4

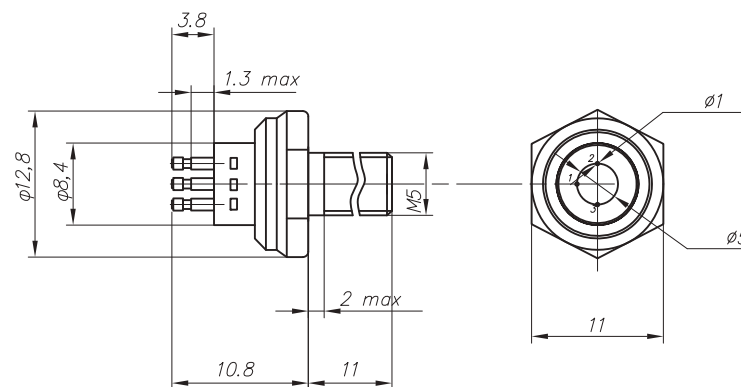
' $G_{ms} \geq 85$ *- $N_r < 6$

'' $G_{ms} \geq 50$ ** $F < 8$

''' $G_{ms} \geq 60$

КТ-4

1. С
2. З
3. И



Выпрямительные быстродействующие диоды HIGH-SPEED DIODES

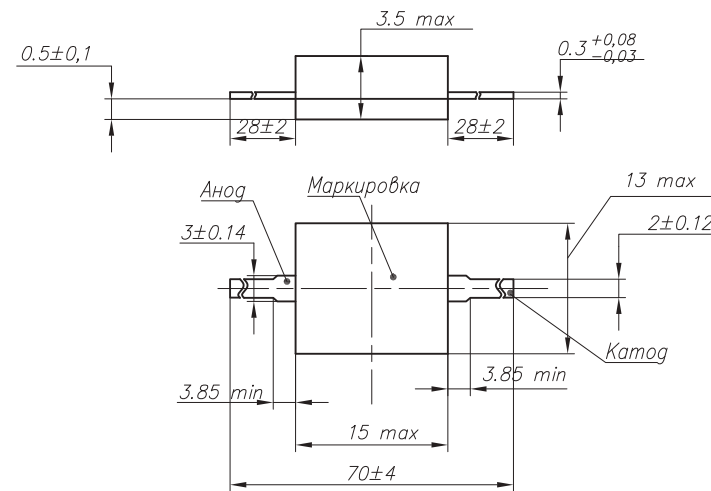
Тип изделия Type number	Г обр.	U пр.	t вос.обр.	Uобр. макс./ Uобр. Н. макс.	Iпр. макс./ Iпр. И макс.	P макс.	f макс.	Case Корпус
	мА	В	нс	В	А	Вт	МГц	
2Д2931А	0,1*	1,5	80	200	30/90	90	0,2	нестанд.
2Д2931Б	0,1**	1,5	80	100	30/90	90	0,2	нестанд.
2Д2931В	0,1***	1,5	80	50	30/90	90	0,2	нестанд.

*U обр.=200В

**U обр.=100В

***U обр.=50В

2Д2931А,Б,В

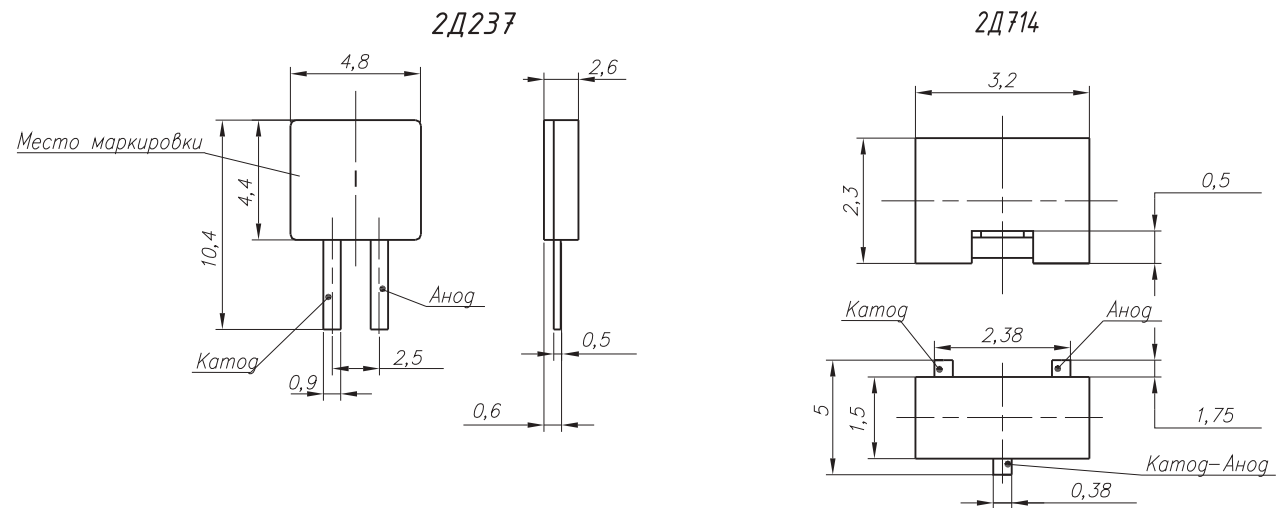


Выпрямительные быстродействующие диоды HIGH-SPEED DIODES

Typenumber Тип изделия	$I_{обр}$	$U_{пр.}$	твос. Обр.	$U_{обр. макс.}/$ $U_{обр. н. макс.}$	$I_{пр. макс.}/$ $I_{пр. и макс.}$	$P_{макс.}$	$f_{макс.}$	Case Корпус
	мА	В	нс	В	А	Вт	кГц	
2Д237А1/ПМ	1*	1,25	50	100/100	1/3· $I_{пр. ср. макс.}$	1,35	300	нестанд.
2Д237Б1/ПМ	1**	1,25	50	200/200	1/3· $I_{пр. ср. макс.}$	1,35	300	нестанд.
2Д237В1/ПМ	1	1,25	15	100/100	1/3· $I_{пр. ср. макс.}$	1,35	300	нестанд.
2Д237Г1/ПМ	1	1,25	15	200/200	1/3· $I_{пр. ср. макс.}$	1,35	300	нестанд.
2Д714АС1	3,0	0,9	6,0	70/70	450	350	2,5	нестанд.
2Д714АС2	3,0	0,9	6,0	70/70	450	350	2,5	нестанд.

* $U_{обр} = 100В$;

** $U_{обр} = 200В$;

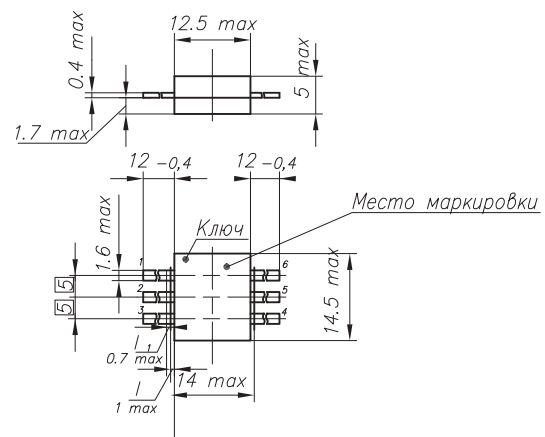


АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
г. Москва, Окружной пр., д.27
тел./факс: +7(499) 369 48 62;
+ 7 (495) 603 56 99
www.gz-pulsar.ru

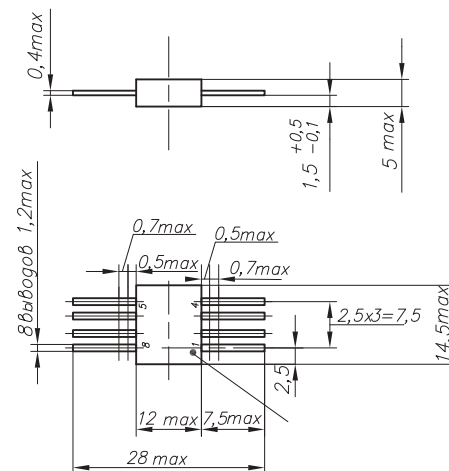
Микросхемы мощные интегральные
Power integrated circuits

Туренumber Тип изделия	И _{т,вых} ,	U _{отг}	U _{вх,отк}	K _{γ,I}	t _{вкл} ,	t _{выкл} ,	Case Корпус
	мА	В	В		мкс	мкс	
286ЕП1АПМ	3	1,20	2,00	10-150	0,15	0,42	427.8-1
286ЕП2АПМ	6	3,00	4,00	2000	0,4	2,40	427.6-1
286ЕП3АПМ	5,0	0,85	1,60	10-200	0,15	0,42	4117.6 - 4
286ЕП4АПМ	7,0	2,00	3,00	2000	0,3	1,00	4117.6 - 4
286ЕП5АПМ	1,0	1,30	2,00	500	0,3	1,00	4117.6 - 4

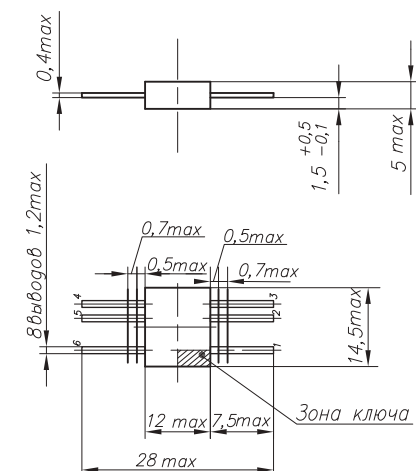
286 ЕП3,4,5



286 ЕП1АПМ



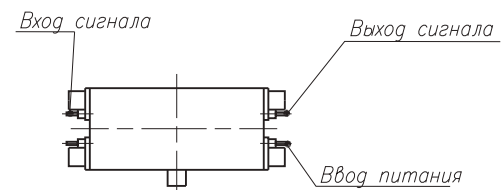
286 ЕП2АПМ



Транзисторные усилители
Transistors amplifiers

Type number Тип изделия	U	f	G _p	F	K _{sw in}	K _{sw out}	P _{lin}	P _{out}	I	Case Корпус
	V	GHz	dB	dB			mW	mW	mA	
M42114-5	12	3...3,5	22	5	1	2	1		50	metal-ceramic package with coaxial leads

M42114-5



Для заметок





АО "ГЗ "ПУЛЬСАР"
г. Москва, Окружной пр., д.27
тел./факс: +7(499) 369 48 62;
+ 7 (495) 603 56 99
www.gz-pulsar.ru

